**Ванюхин Кирилл Дмитриевич. Технология создания омических контактов для полупроводниковых приборов на основе гетероструктур AlGaN/GaN и InGaN/GaN: автореферат дис. ... кандидата технических наук: 05.27.01 / Ванюхин Кирилл Дмитриевич;[Место защиты: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", ods.mephi.ru].- Москва, 2015**